


	<h2 style="color: red;">FQD19N10TF</h2> <p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> FQD19N10TF</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> Fairchild/ON Semiconductor</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 100V 15.6A DPAK</p> <p><b>Datenblätter:</b> <a href="#">1.FQD19N10TF.pdf</a> <a href="#">2.FQD19N10TF.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 5000 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	FQD19N10TF
Hersteller	Fairchild/ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 100V 15.6A DPAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	5000 pcs Stock
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Supplier Device-Gehäuse	D-Pak
Verlustleistung (max)	2.5W (Ta), 50W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 °C	15.6A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	100 mOhm @ 7.8A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	25nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	780pF @ 25V
Verpackung	Tape & Reel (TR)

FQD19N10TF ist neu im Original, Suche FQD19N10TF Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQD19N10TF Fairchild/ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FQD19N10TF: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>FQD19N10TM_F080</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 15.6A DPAK</p>	 <p><b>FQD19N10LTF</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 15.6A DPAK</p>	 <p><b>FQD19N10L FQD19N10</b> FAIRCHILD FAIRCHILD SOT-252</p>	 <p><b>FQD19N10LTM</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 15.6A DPAK</p>
 <p><b>FQD19N10LTM</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 15.6A DPAK</p>	 <p><b>FQD19N10TM</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 15.6A DPAK</p>	 <p><b>FQD19N10TF</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 15.6A DPAK</p>	 <p><b>FQD19N10LTF</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 15.6A DPAK</p>

### heiße Teile

Mehr

<a href="#">FQD16N15</a>	<a href="#">FQD16N25C</a>	<a href="#">FQD16N25CTM</a>	<a href="#">FQD16N25CTM</a>	<a href="#">FQD16N25L</a>
<a href="#">FQD17N08</a>	<a href="#">FQD17N08L</a>	<a href="#">FQD17N08LTF</a>	<a href="#">FQD17N08LTF</a>	<a href="#">FQD17N08LTM</a>
<a href="#">FQD17N08LTM</a>	<a href="#">FQD17N10</a>	<a href="#">FQD17P06</a>	<a href="#">FQD17P06TF</a>	<a href="#">FQD17P06TF</a>
<a href="#">FQD17P06TM</a>	<a href="#">FQD17P06TM</a>	<a href="#">FQD18N20V2</a>	<a href="#">FQD18N20V2TM</a>	<a href="#">FQD18N20V2TM</a>
<a href="#">FQD19N10</a>	<a href="#">FQD19N10L</a>	<a href="#">FQD19N10LTM</a>	<a href="#">FQD19N10LTM</a>	<a href="#">FQD19N10TF</a>
<a href="#">FQD19N10TM</a>	<a href="#">FQD19N10TM</a>	<a href="#">FQD1N50B</a>	<a href="#">FQD1N50TF</a>	<a href="#">FQD1N50TF</a>
<a href="#">FQD1N60C</a>	<a href="#">FQD1N60CTF</a>	<a href="#">FQD1N60CTF</a>	<a href="#">FQD1N60CTM</a>	<a href="#">FQD1N60CTM</a>
<a href="#">FQD1N60TF</a>	<a href="#">FQD1N60TF</a>	<a href="#">FQD1N60TM</a>	<a href="#">FQD1N60TM</a>	<a href="#">FQD1N80TM</a>
<a href="#">FQD1N80TM</a>	<a href="#">FQD1P50TM</a>	<a href="#">FQD1P50TM</a>	<a href="#">FQD20N06</a>	<a href="#">FQD20N06-NL</a>
<a href="#">FQD20N06L</a>	<a href="#">FQD20N06LE</a>	<a href="#">FQD20N06LETM</a>	<a href="#">FQD20N06LETM</a>	<a href="#">FQD20N06LTF</a>

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited